# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-339960

(43) Date of publication of application: 10.12.1999

(51)Int.CI.

H05B 33/14 G09F G09F 13/22

(21)Application number : 10-147220

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

28.05.1998

(72)Inventor: HIMESHIMA YOSHIO

**FUJIMORI SHIGEO KOHAMA TORU** 

# (54) LUMINESCENCE ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent luminance irregularity in a plane and local shortcircuiting by laminating a material controlling the luminescence by electric energy between a positive electrode and a negative electrode, and suppressing the film thickness variation of each layer controlling luminescence to specific % or below.

SOLUTION: Resistance heating deposition and electron beam deposition are desirous for forming a material controlling luminescence in view of characteristics. The film thickness variation is the ratio between the minimum film thickness and maximum film thickness in a plane. When this value (thickness irregularity) is within 50%, a luminance irregularity cannot be visually sensed. A deposition material is arranged at a position deviated from the normal line drawn from the center of gravity of a substrate to be deposited in order to suppress the inplane film thickness variation within 50%. The angle between the normal line and the line connecting a deposition source and the center of gravity is preferably set to 10° or above. Any method of rotation, revolution, or rotation/revolution may be used to rotate the substrate, and the method is selected according to the substrate and a pattern shape. The revolving speed is selected from 3-30 rpm in consideration of the nature and thickness irregularity of the formed film.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

JP11-339960

5

[Claim 1] An area light emitting element characterized in that light emitting material is laminated between an anode and a cathode, the light emitting material emits light due to electrical energy, the film thickness fluctuation in each of light emitting layers is equal to or less than 50%.

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-339960

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	FI
H05B 33/14		H 0 5 B 33/14 A
G09F 9/30	365	G09F 9/30 365Z
13/22		13/22 A
H 0 5 B 33/10		H 0 5 B 33/10
		審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 (71)出願人 000003159 東レ株式会社
(21)出顯番号	特願平10-147220	(71) 出願人 000003159
		東レ株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 5月28日	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1
		(72)発明者 姫島 義夫
		磁賀県大津市園山1丁目1番1号 東
		磁質県大津市園山1丁目1番1号 東 式会社磁質事業場内
		(72)発明者 藤森 茂雄
		磁賀県大津市園山1丁目1番1号 東
		式会社滋賀事業場内
		(72)発明者 小濱 亨
		滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東
		式会社滋賀事業場内

## (54) 【発明の名称】 発光素子及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】輝度ムラのない面状発光素子を提供する。

【解決手段】陽極と陰極の間に発光を司る物質が積層され、電気エネルギーによって発光し、該発光を司る各層の面内膜厚変動が50%以下であることを特徴とする面状発光素子およびその製造方法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極の間に発光を司る物質が積層さ れ、電気エネルギーによって発光し、該発光を司る各層 の面内膜厚変動が50%以下であることを特徴とする面 状発光素子。

【請求項2】該発光素子が陽極、正孔輸送材料、発光材 料、陰極からなることを特敵とする請求項1記載の発光 素子。

【請求項3】陽極、陰極および/または発光を司る物質 請求項1記載の発光素子。

【請求項4】基板の中心に法線方向からずらした位置に 蒸着源を配置し、基板を回転させながら発光を司る各層 の面内膜厚変動を50%以下にすることを特徴とする請 求項1記載の面状発光素子の製造方法。

【請求項5】基板の回転数が3~30rpmであること を特徴とする請求項1または4記載の面状発光素子の製

【請求項6】基板と蒸着源の間にバターニングを行うた めのシャドーマスクを配置することを特徴とする請求項 20 1~5のいずれか記載の面状発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネ ルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標 識、看板、電子写真機、光信号発生器などの分野に利用 可能な発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入 30 された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する 際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年 活発に行われるようになってきた。この素子は、薄型、 低駆動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによ る多色発光が特徴であり注目を集めている。

【0003】この研究は、コダック社のC. W. Tan gらが有機積層薄膜素子が高輝度に発光することを示し て以来 (Appl. Phys. Lett. 51 (12) 21, p. 913, 1987)、多くの研究機関が検討 を行っている。コダック社の研究グループが提示した有 40 機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基 板上に正孔輸送性のジアミン化合物、発光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてM g: Agを順次真空蒸着法で設けたものであり、10V 程度の駆動電圧で1000cd/m²の緑色発光が可能 であった。現在の有機積層薄膜発光素子は、上記の素子 構成要素の他に電子輸送層を設けているものなど構成を 変えているものもあるが、基本的にはコダック社の構成 を踏襲している。一方、真空蒸着法以外の手法として

ングやスピンコーティングなどの手法を用いて薄膜を形 成する方法などが知られている (Nature, 347, p. 539(199

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来知られて いる手法を用いた場合、面内の輝度ムラや局所的な短絡 現象が観察されていた。この現象は、真空蒸着法におい ては基板を回転させない場合に顕著であり、また回転さ せた場合でも蒸着源と基板の位置関係で十分な特性が得 が所定の形状にパターン化されていることを特徴とする 10 られない場合があった。更にコーティング法では、この 傾向が著しく現れていた。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記目的を 達成するために鋭意検討した結果、陽極と陰極の間に発 光を司る物質が積層され、電気エネルギーによって発光 し、該発光を司る各層の面内膜厚変動が50%以下に抑 えることにより課題を解決できることを見出し、本発明 に到達した。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において陽極は、光を取り 出すために透明であれば酸化錫、酸化インジウム、酸化 錫インジウム(ITO)などの導電性金属酸化物、ある いは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅など の無機導電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポ リアニリンなどの導電性ポリマなど特に限定されるもの でないが、ITOガラスやネサガラスを用いることが特 に望ましい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流 が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電 力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば3 00Q/□以下のITO基板であれば素子電極として機 能するが、現在では10♀╱□程度の基板の供給も可能 になっていることから、低抵抗品を使用することが特に 望ましい。ITOの厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ 事ができるが、通常100~300nmの間で用いられ ることが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラ ス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも機械 的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、0.5 mm以上あれば十分である。ガラスの材質については、 ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカ リガラスの方が好ましいが、SiO、などのバリアコー トを施したソーダライムガラスも市販されているのでと れを使用できる。ITO膜形成方法は、電子ビーム法、 スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受けるも のではない。

【0007】陰極は、電子を本有機物層に効率良く注入 できる物質であれば特に限定されないが、一般に白金、 金、銀、銅、鉄、錫、亜鉛、アルミニウム、インジウ ム、クロム、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシ ウム、マグネシウムなどがあげられるが、電子注入効率 は、髙分子化合物を溶媒に溶解して、ディップコーティ 50 をあげて素子特性を向上させるためにはリチウム、ナト

3

リウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムまたはこ れら低仕事関数金属を含む合金が有効である。しかし、 これらの低仕事関数金属は、一般に大気中で不安定であ ることが多く、例えば、有機層に微量のリチウムやマグ ネシウム (真空蒸着の膜厚計表示で1 n m以下)をドー ピングして安定性の高い電極を使用する方法が好ましい 例として挙げることができるが、フッ化リチウムのよう な無機塩の使用も可能であることから特にこれらに限定 されるものではない。更に電極保護のために白金、金、 銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウムなどの金 属、またはこれら金属を用いた合金、そしてシリカ、チ タニア、窒化ケイ素などの無機物、ポリビニルアルコー ル、塩化ビニル、炭化水素系髙分子などを積層すること が好ましい例として挙げられる。これらの電極の作製法 も抵抗加熱、電子線、スパッタリング、イオンプレーテ ィング、コーティングなど導通を取ることができれば特 に制限されない。

【0008】発光を司る物質とは、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、そして、4)以上の組合わせ物質を一 20層に混合した形態のいずれであってもよい。即ち、素子構成としては、上記1)~3)の多層積層構造の他に4)のように発光材料単独、または発光材料と正孔輸送材料と電子輸送材料、あるいは発光材料と正孔輸送材料または電子輸送材料を含む層を一層設けるだけでもよい。

【0009】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独または二 種類以上の物質を積層、混合するか正孔輸送性物質と髙 分子結着剤の混合物により形成され、正孔輸送性物質と してはN, N´-ジフェニル-N, N´-ジ(3-メチ 30 ルフェニル) - 4, 4 ~-ジフェニル - 1, 1 ~-ジアミン、N, N´ージナフチルーN, N´ージフェニルー 4, 4 - ジフェニルー1, 1 - ジアミンなどのトリ フェニルアミン類、ビス(N-アリルカルバゾール)ま たはビス(N-アルキルカルバゾール)類、ピラゾリン 誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、オ キサジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体、ポルフ ィリン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマー系で は前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレ ン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシラン、ポリ 40 チオフェン、ポリアニリン、ポリフェニレンビニレンな どが好ましいが、素子作製に必要な薄膜を形成し、陽極 から正孔が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物 であれば特に限定されるものではない。

ル誘導体、水酸基を有するベンズオキサゾール誘導体の金属錯体、ベンズチアゾール誘導体、水酸基を有するベンズチアゾール誘導体、水酸基を有するベンズチアゾール誘導体の金属錯体、フラボン誘導体の金属錯体、ジスチリルアリレン系誘導体、ピリミジン誘導体、シロール誘導体、ピフェニルーp-(t-ブチル)フェニルー1,3,4-オキサジアゾールをはじめとするオキサジアゾール誘導体、オリゴフェニレン誘導体、ピロロピロール誘導体、ポルフィリン誘導体、スピロオリゴフェニレン誘導体、フェナントロリン誘導体などが挙げられるがこれらに限定されるものではない。

【0011】また、発光効率向上、発光色変換や色純度 向上のためにドーピングの手法が用いられる。ドーピン グに使われるドーパントとしては上記発光材料の他にク マリン誘導体、キナクリドン誘導体、ルブレン誘導体、 ペリレン誘導体、ジシアノスチリルピラン誘導体、ロー ダミン誘導体、ペリレン誘導体、ユーロピウム錯体誘導 体、テルビウム金属錯体、ピロメテン誘導体、フタロシ アニン誘導体、オキサジン誘導体などが挙げられるがと れらに限定されるものではない。ドープ量は、多い方が 発光効率が上がると考えられるが、多くの蛍光体は高濃 度になると濃度消光現象が起こることと有機薄膜の膜質 の観点から最適濃度が存在する。多くのドーパントの場 合、ホストに対するドーパントの濃度は10%以下、好 ましくは5%以下、更に好ましくは1%以下であること が多いが特に限定されるものではない。ドーピング方法 は、蒸着における共蒸着、混合蒸着、または混合塗布法 などがある。

【0012】電子輸送性物質としては、電界を与えられ た電極間において陰極からの電子を効率良く輸送すると とが必要で、電子注入効率が高く、注入された電子を効 率良く輸送することが望ましい。そのためには電子親和 力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さらに安定性 に優れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に 発生しにくい物質であることが要求される。本発明に関 する発光材料は、電子輸送性能も兼ね備えてるので、発 光材料だけではなく電子輸送層の材料としても有用であ る。従って、本化合物は何等発光することなく電子のみ を素子の中で輸送する役割も果たすし、発光層兼電子輸 送層として働かせることも可能である。また、本発明に 関する材料は、オキサジアゾール、トリアゾール、フェ ナントロリン、キノキサリン、キノリノラト金属錯体な どの誘導体と混合したり、積層して用いることもでき る。本発明に関する材料が発光材料である場合は、前記 オキサジアゾール、トリアゾール、フェナントロリン、 キノリノラト金属錯体などの誘導体を単独または二種類 以上混合して用いてもよい。

【0013】以上述べてきた化合物以外にも蒸着可能な高分子化合物が存在するし、モノマーを蒸着して基板上で重合する方法もあることから、特に材料には制限はない。

【0014】発光を司る物質の形成方法は、抵抗加熱蒸 着、電子ビーム蒸着、スパッタリング、分子積層法など 特に限定されるものではないが、通常は、抵抗加熱蒸 着、電子ビーム蒸着が特性面で好ましい。層の厚みは、 発光を司る物質の抵抗値にもよるので限定することはで きないが、10~1000nmの間から選ばれる。 【0015】電気エネルギーとは主に直流電流を指す が、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。 電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電 力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大 10 の輝度が得られるようにするべきである。

【0016】本発明における面内膜厚変動とは、一つの デバイスとして機能する発光を司る物質層の変動を指 す。即ち、発光を司る物質が一層であればその膜厚変動 であり、複数層積層されている場合は、各層の膜厚変動 を指す。そして、その膜厚変動とは、平面内の最少と最 大膜厚の比率を指している。例えば膜厚変動が50%と は薄い所の膜厚を1とすると厚いところが1.5である ことを意味する。発光を司る物質層は、電極と発光を司 る物質層共にパターン化しないもの、電極のみをパター 20 ン化して発光を司る物質層はバターン化しないもの、電 極と発光を司る物質層共にバターン化した何れの形態も 取り得る。従って、パターン化した場合は各領域内の厚 みムラではなく表示領域全体の厚みムラを意味してい る。この厚みムラが50%以内であれば視覚的に感知で きない程度の輝度ムラになるが、ムラのある領域が近い 場合は感知され易いので好ましくは30%、更に好まし くは15%以下であることが望ましい。これらは、各層 の膜厚を示していることから、例えば各層の厚みムラが 15%ずつであれば、全体厚みのは最少で15%(1. 15×1×1)、最大で52%(1.15×1.15× 1. 15)ということになる。この計算は、他の如何な る厚みムラの値に対しても適用することが可能である。 また膜厚の測定は、デバイスとして機能する平面の重心 点、そして周辺の対角4点を透過型電子顕微鏡(TE M)、走查型電子顕微鏡(SEM)、原子間力顕微鏡 (AFM) または触針式粗さ計などで行う。従って、本 発明に於ける厚みムラとは、局部的な厚みムラ(例えば 単一画素素子の中心部と周辺部)を指すわけではなく、 あくまでもデバイス全体領域にわたる厚み分布を指して 40 いる。

【0017】本発明においてパターニングとは、情報表 示を行うのに必要な形状に画素を形成させることを言 う。その形状としては、マトリクス形状やセグメント形 状が挙げられる。

【0018】マトリクス形状とは、表示のための画素が 格子状に配置されたものをいい、画素の集合で文字や画 像を表示する。画素の形状、サイズは用途によって決ま る。例えばパソコン、モニター、テレビの画像および文

が用いられるし、表示パネルのような大型ディスプレイ の場合は、一辺がmmオーダーの画素を用いることにな る。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を配列すれば よいが、カラー表示の場合には、赤、緑、青の画素を並 べて表示させる。この場合、典型的にはデルタタイプと ストライプタイプがある。そして、このマトリクスの駆 動方法としては、線順次駆動方法やアクティブマトリッ クスのどちらでもよい。線順次駆動の方が構造が簡単で あるという利点があるが、動作特性を考慮した場合、ア クティブマトリックスの方が優れる場合があるので、と れも用途によって使い分けることが必要である。

【0019】本発明におけるセグメント形状とは、予め 決められた情報を表示するようにパターンを形成し、決 められた領域を発光させることになる。例えば、デジタ ル時計や温度計における時刻や温度表示、オーディオ機 器や電磁調理器などの動作状態表示、自動車のパネル表 示などがあげられる。そして、前記マトリクス表示とセ グメント表示は同じパネルの中に共存していてもよい。 【0020】本発明における面状発光素子の製造方法

は、前記課題を解決するために面内膜厚分布を50%以 内に抑制できるものである。即ち、蒸着される基板の重 心から引かれた法線上から蒸着物質をずらした位置に配 置することを特徴とする。法線と蒸着源と重心を結ぶ線 のなす角度が10°以上であることが好ましい。また、 マスク蒸着を行う場合は、影となる部分を減らすために 25°以上の角度にすることが更に望ましいが、形状な どに影響されるので法線からずらす以外に特別な限定は ない。また、蒸着源の数は特に制限されず同時に2つ以 上の蒸着源から蒸着させても良い。

【0021】基板の回転は、自転、公転、自公転のいず 30 れの方式も取り得ることが可能であり、基板やパターン 形状に合わせて選択することができる。回転速度は、特 に限定されないが通常1~100 г р mから選ばれる。 回転速度は、一層を形成させるに必要な時間とも関係が あり、短時間で形成される層の場合は回転速度を速くす る方が好ましい。通常、形成された膜の膜質と厚みムラ を考慮すると、3~30 r p m から選択される場合が多 いが特に限定されるものではない。

[0022]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

【0023】参考例

蒸着源を、法線から15°の角度の位置に配置して、自 転で基板を回転(10rpm)ながらN、N^-ジフェ ジフェニルー4、4'ージアミン(TPD)を抵抗加熱 方式によって0.3mm/秒の速度で130mm蒸着 し、続いてトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを 字表示には、通常一辺が300μm以下の四角形の画素 50 蒸着した。パネルの対角4点と重心点を透過電子顕微鏡 7

(日立H-600型、加速電圧100kV、エポキシ包 埋超薄切片法で500オングストロームに調整)で観察 したところ、膜厚変動はそれぞれ15%と21%であっ た。

#### 【0024】実施例1

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (150/□、電子ピーム蒸着品)を対角4インチの大 きさに切断後、ストライプ状にエッチングし(ピッチー 00μm) 洗浄を行った。これを使用前にUV-オゾン 洗浄して直ちに真空蒸着装置内に設置して、装置内の真 10 【0027】比較例1 空度が5×10-6Torr以下になるまで排気した。 【0025】まず、正孔輸送材料であるN, N'-ジフ x=1 N' - (3-x+1) - 1, 1'-ジフェニル-4, 4'-ジアミン(TPD)を抵抗加 熱方式によって0.3 nm/秒の速度で130 n m蒸着 し、続いてトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを 0.3nm/秒の速度で100nm蒸着した。この時蒸 着源は、法線から15°の角度の位置に配置され、基板 は自転で回転速度は10rpmであった。次に300μ

mのストライプ状の電極が形成されるようにマスクを装 着した後、リチウムを0.1nm/秒の速度で1nm、 最後にアルミニウムを0.5nm/秒の速度で500n m蒸着してパネルを作製した。このパネルを直流駆動し たときの輝度ムラは視覚的には認識できなかった。

#### 【0026】実施例2

蒸着角度が27°である以外は実施例と同様にしてパネ ルを作製したところ、このパネルを直流駆動したときの 輝度ムラは視覚的には認識できなかった。

基板を回転させず、蒸着源を基板の法線上に配置したと と以外は実施例1と同様にしてパネルを作製したとこ ろ、膜厚変動は62%であり、陽極、陰極のそれぞれの 電極を短絡させて直流駆動したときの輝度ムラが視覚的 に認識された。

#### [0028]

【発明の効果】本発明は、輝度ムラのない面状発光素子 を提供するものである。